

## ДИСПЛЕЙ – УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРИЯДЕРНЫМИ ПРОЦЕССАМИ

### *Аннотация*

Дисплей представляет собой два электрода, рассеянных одной плоскостью, билтоны которых должны располагаться параллельно рассеянной поверхности.

Группы электронов тока и встречных положительных электрических пострино выходят из полюсов ядер атомов одновременно и входят во второй электрод также все одновременно, что говорит о том, что скорость перемещения этих групп в межэлектродном промежутке больше скорости света, так как диаметры этих электродов несоизмеримы.

Все энергоинформационные обмены осуществляются только в полюсах ядер атомов в промежутки времени после завершения полупериода циклических колебаний наружных атринов пульсесдов и до завершения перехода полюсов наружными атринами пульсесдов. Силовая связь между полюсами ядер атомов и внешними пострино осуществляется в момент завершения полупериода циклических колебаний наружных атринов атомов.

Производная вистра биртрона электрона устанавливает силовую связь с информационным пострино, превращаясь в витру, увеличивает количество векторов адрат в своих сериях, что приводит к превращению информационного пострино в фотон. Фотон излучается из поверхности ядра атома, создавая прецедент нахождения расположения эфаны Ариадны полупроводника. Биртрон ядра атома синтезирует производные пострино и «выпрыгивает» из полюса ядра атома, сокращая новое производное пострино.

На дисплее компьютера имеется эфана Ариадны, создаваемая источником ЭДС, и эфана Ариадны полупроводника, создаваемая полупроводником. Это две разных эфаны, они выполняют функцию соединения только на дисплее в полюсах ядер атомов поверхности дисплея. Свечения дисплея – это один процесс, а транспортировка электрона тока – это другой процесс на дисплее.

Весь процесс, происходящий на дисплее, заранее запрограммирован Космическим Разумом. Без участия Космического Разума невозможно было бы получить эпострисики, эфаны Ариадны полупроводника и информационное пострино. Энергия не имеет толщины.

Свидетельства процессов на дисплее всех полупроводниковых приборов является доказательством того, что Космический Разум специально создал полупроводники, наделив их свойствами, которые пропагандирует стандартная модель физики.

### *Оглавление*

Новые термины
Введение
1. Работа фотоаппарата
2. USB-флеш – накопитель
3. Полупроводниковый дисплей
4. Курсор
5. Выделение любого объекта
6. Удаление любого объекта
7. Копирование любого объекта
8. Сохранение любого объекта
9. Печать
10. Заливка
Выводы
Литература

### *Новые термины*

**Вистра коренная** – вистра, синтезируемая из гравитона в момент радиоактивного распада нейтрона.

**Вистра производная** – вистра, синтезируемая коренной вистой для компенсации магнитного поля коренной вистры.

**Закон сохранения внутренней энергии системы** - при скачкообразном перемещении в полюс ядра атома электрона тока не происходит увеличения кинетической энергии электронов.

**Полупроводниковый отрицательный переход** – это усечение энергии положительных электрических пострино при выходе их из полюсов ядер атомов последнего слоя полупроводника в слой поликристаллического металла или слой металла, напыленного на другой проводник.

**Пострино главное** – пострино, синтезируемое эпострисом, которое располагается симметрично ему и сразу же увеличивает размер серий до комптоновской длины волны. У главного пострино задача - доставить электрон после излучения к ядру того же атома.

**Пострино производное** – синтезируется в результате подсоединения энергии пострино к сериям спола первым рядом квантонов спола. Задача производного пострино - обеспечить перемещение электрона в промежутках, в которых отсутствует возможность перемещения его на главном пострино.

**Пострино информационное** – электрические серии, синтезируемые в полюсе ядра атома в результате действия эпострисика, перемещающиеся со скоростью света по эфана Ариадны полупроводника с размером комптоновской длины волны в каждый новый полупериод циклических колебаний атринов ядра атома.

**Эпострис** – это временная энергия для ионизации атома, которая формируется за счет энергии, пришедшей извне (фотоны), а также за счет энергии, синтезируемой одним из атринов электрона ядра атома в результате электромагнитной индукции. Эпострис располагается вдоль секры вистры спола в филбайтинге вдоль пульсэда.

**Эпострисик** – это электрические серии, которые синтезируются в ядрах атомов из электрических пострино при торможении в конденсаторе колебательного контура серии энергии, идущей от ядер атомов полупроводника дисплея. Эпострисики располагаются вдоль производных вистр секры электрона в филбайтинге.

**Эфана Ариадны** – синтезируется атомом, который получил избыточную энергию накануне возможной его ионизации, в момент синтеза эпостриса, выходит из полюса ядра атома симметрично эпострису и оканчивается в первом ряду квантонов эпостриса. Ситуационная кольцевая эфана замыкает цепь тока источника ЭДС. Непрерывные серии эфаны Ариадны начинаются у серии вистр флаты спола в направлении выхода трансэлпосов и оканчиваются на вистрах флатр спола при вхождении электронов тока в ионы для рекомбинации. При этом все цуги положительных пострино, контактирующих с эфаной Ариадны, и сама эфана Ариадны, аннигилируют.

**Эфаны Ариадны полупроводника** - эфана полупроводника, которая синтезируется в момент рождения эпострисика. Выходит из полюса ядра атома в противоположном направлении от эпострисика и оканчивается в полюсе ядра атома со стороны эпострисика.

## ***Введение***

Компьютеры, смартфоны и другая оргтехника разработаны на основе Атрисной физики и глубокого осмысления программирования – IT-технологии.

Можно предположить, что авторам оргтехники известна Атрисная физика. Но, может им помог эксперимент, или они засекретили фундаментальную теорию, которая отрицает Стандартную модель физики. По-видимому, специалистам США была передана информация о технологии изготовления компьютеров и смартфонов Бильдерберским клубом, созданном в 1954 году.

Все пользователи сети признали, что оргтехника изготовлена на основе фундаментальной науки и успокоились. На первое место вышли IT-технологии, которые не нуждаются в знаниях протекающих процессов в микросхемах приборов. Однако, знания элементарных процессов, протекающих в микросхемах приборов, расширяют возможности управления этими технологиями. Процессы, которые происходят на поверхности дисплея, были заранее предусмотрены Космическим Разумом.

На дисплеях идет только визуализация излучения, а информация хранится в чипах колебательных контуров.

Вся оргтехника работает на полупроводниках. Знание свойств различных полупроводников позволило создать целую индустрию по продаже и использованию оргтехники.

*Отличие проводников от полупроводников заключается в том, что полупроводники не имеют пороговой энергии ионизации, а все процессы в полупроводниковой оргтехнике используют отрицательный полупроводниковый переход.*

## **1. Работа фотоапарата**

К поверхности полупроводникового диода подведено оптимальное напряжение, которое не дает возможности электронам тока выходить за пределы полюсов ядер атомов, так как энергия главного пострино равна энергии, которую должна затратить производная вистра биртрона электрона, чтобы его вырвать из полюса ядра атома. Если на поверхность электрода не падает световая энергия, ток через прибор не проходит. Однако, производная вистра биртрона электрона продолжает устанавливать силовую связь с центром главного пострино и сокращается, в результате чего синтезируется отрицательное электрическое поле. Если на поверхность электрода падают световые лучи, то они преобразуются в энергию информационных пострино, которая располагается параллельно энергии главного пострино. Только в этом случае производная вистра биртрона электрона вырывает полюс электрона из полюса ядра атома и превращает валентный электрон в электрон тока. Необходимо отметить, что невозможно увеличить энергию главных пострино за счет накачки энергии. Энергия фотонов превращается в энергию информационных пострино. На этом принципе построены все полупроводниковые приборы.

Из полюсов ядер атомов полупроводника фотодиода выходит одновременно два пострино - главное и информационное, которые движутся параллельно вдоль эфаны Ариадны. Если ток идет к поверхности дисплея, на выходе из полюсов ядер атомов информационное пострино попадает под действие производной вистры биртрона, устанавливает количество векторов адрут в соответствии с количеством векторов адрут в информационном пострино. Это приводит к превращению производной вистры биртрона в витру, а серии информационных пострино – в серии фотона.

Таким образом, свет, фокусирующийся на рабочей поверхности полупроводникового прибора, превращается в информационное пострино, которое проходит к поверхности дисплея, где в полюсах ядер атомов осуществляется трансформация информационных пострино в фотоны. Наблюдатель сразу видит тот предмет, который создает данное изображение.

К поверхности дисплея подводится напряжение. Информационные пострино перемещаются к поверхности дисплея и создают изображение. Если информационные пострино направляются к полупроводнику в виде флеш-накопителя, информационные пострино достигают торца накопителя, а электроны тока выходят с флеш-накопителя и продолжают свое движение к источнику ЭДС. Достигнув торца флеш-накопителя, информационные пострино останавливаются, перемещаясь вдоль производной вистры секры электрона в филбайтинге. Серии информационного пострино сжимаются и приобретают размер, равный размеру вистры. Синтезируется новая частица – *эпострисик*, которая сразу же синтезирует *эфану Ариадны полупроводника* и *информационное пострино*.

Избыточная энергия, которую получили серии трансэлпосов, не в состоянии пересечь границу полюса и выйти за пределы флеш-накопителя (чипа). Остаток энергии сохраняется на вистре секры спола на филбайтинге, и образуется новая частица – *эпострисик*. *Эпострисик* располагается только на одной вистре секры, которая расположена в направлении движения серий трансэлпосов (рис. 1).

*Эпострисик* не способен существовать длительное время без синтеза аналогичной энергии симметрично полюсу ядра атома (зеркальное копирование), поэтому свободная вистра секры электрона в полюсе синтезирует себе *эфану Ариадны полупроводника*, которая выходит из полюса ядра атома, создает кольцевую *эфану* и входит в полюс ядра атома с диаметрально противоположной стороны.

За время порядка  $10^{-65}$  сек происходит синтез *эфаны Ариадны полупроводника* и мгновенно же синтез избыточной энергии, равной по величине энергии *эпострисика* (зеркальное

копирование). Этот процесс практически невозможно проследить. Как только синтезировалась новая избыточная энергия, она сразу же передается от серий вистры секры электрона спола сериям эфаны Ариадны полупроводника и заполняет всю комптоновскую длину волны:

$$\lambda = 2r_F,$$

где:  $\lambda$  - длина волны Комптона,  $r_F$  – радиус наружных серий филбайтинга.

Начинается движение нового информационного пострино по поверхности эфаны Ариадны полупроводника. В каждый новый полупериод циклических колебаний атринов ядра атома синтезируется новое пострино – *информационное пострино*, которое сообщает о наличии избыточной энергии у ядра атома полупроводника. Существование избыточной энергии у полупроводника атома или эпострисика может оставаться неизменным, пока на ядро атома не подействуют отрицательными электрическими пострино. Происходит мгновенная ликвидация эфаны Ариадны полупроводника всех информационных пострино и, собственно, эпострисика. Этот процесс осуществляется во всех полупроводниковых приборах при ликвидации изображений.

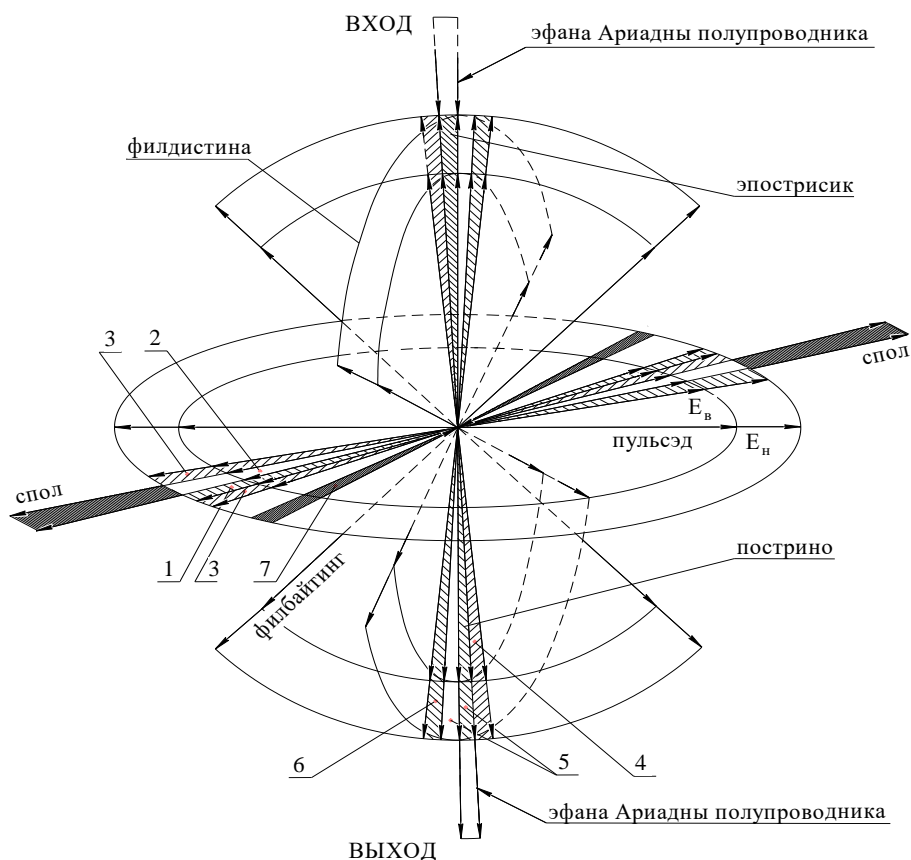


Рис. 1. Синтез эфаны Ариадны полупроводника.

Для фиксации изображения, необходима команда: «сохранить». Только в этом случае получается зафиксированное изображение – фото. Для осуществления команды «сохранить» необходимо сделать три «клика» на поверхность дисплея или, другими словами, соединить первые ряды квантонов эпострисика с первым рядом квантонов эфаны Ариадны полупроводника.

## 2. USB-флеш - накопитель

Опишем механизм записи информации на микросхему флеш-памяти.

Запись, сделанная в чипах компьютера, непрерывно генерирует эфаны Ариадны полупроводника, по которой движутся информационные пострино. Для записи информации на микросхему флеш-памяти производится совмещение эфаны Ариадны и эфаны Ариадны полупроводника. Одновременно к микросхеме флеш-памяти движутся электроны тока и информационные пострино. Как только ввели эфаны Ариадны полупроводника в микросхему

флеш-памяти, электроны тока продолжают свое движение до торца микросхемы, а электроны тока через второй контакт полупроводника уходят к источнику ЭДС. Информационные пострино достигают последнего слоя ядер атомов микросхемы флеш-памяти, сжимаются вдоль производной вистры секры электрона в филбайтинге и превращаются в эпострисики, которые сразу синтезируют собственную эфану Ариадны полупроводника и информационные пострино, которые выходят за пределы микросхемы. В одном слое ядер атомов микросхемы флеш-памяти располагается количество ядер атомов, соответствующее количеству ядер атомов полупроводника в дисплее.

В чипе прибора записана информация, соответствующая информации, выносимой из поверхности дисплея. Пока не заполнится первый слой информации в виде эпострисиков, второй слой заполниться не может. За первым слоем идет заполнение второго, и так до тех пор, пока вся информация не будет записана на микросхему флеш-памяти. Информация с микросхемы флеш-памяти снимается с тех же контактов, по которым она поступила в микросхему. Присутствие электронов в микросхеме флеш-памяти не предусмотрено. Информация в микросхеме флеш-памяти будет храниться до тех пор, пока будут существовать эпострисики. Разрушить микросхему флеш-памяти можно через прохождение тока через нее.

### **3. Полупроводниковый дисплей**

Полупроводниковый дисплей изготовлен таким образом, что одно ядро атома полупроводника занимает пространство  $10^{-4}$ – $10^{-5}$  м. Поэтому, на дисплее в процессе участвует только один атом полупроводника из миллиона, все другие участие не принимают.

Биртроны электронов полупроводника располагаются перпендикулярно плоскостям билтонов ядер атомов. При этом каждое положительное электрическое пострино проходит только через одно ядро атома полупроводника.

В компьютере параллельно эфане Ариадны располагается эфана Ариадны полупроводника. По эфане Ариадны движется электрон тока, по эфане Ариадны полупроводника перемещается информационное пострино. Когда первый слой ядер атомов достигают информационные пострино и электроны тока, выход информационных пострино за пределы полупроводника становится невозможным. Производная вистра биртрона электрона устанавливает силовую связь с сериями информационных пострино и теряет силовую связь в биртронном электрона. В отсутствие производной вистры биртрона электрон сразу восстанавливает ее за счет эфира. Производная вистра биртрона, установив силовую связь с сериями информационных пострино, превращается в витру, на которую устанавливается количество векторов адрут в соответствии с энергией информационных пострино. Витра увеличивает амплитуды пульсаций векторов атрисов квантонов и превращает информационные пострино в фотоны, свечение которых и наблюдают на поверхности дисплея. Электрон тока при помощи производной вистры биртрона устанавливает силовую связь с центром главного пострино, и сжимается. Электрон тока выпрыгивает из полюса ядра атома полупроводника, и по эфане Ариадны со скоростью больше скорости света направляется к точке входа электрического тока в прибор.

Назначение электронов тока в полупроводниках такое же, как и у проводников: перемещаться вдоль эфаны Ариадны на трансэлпосах навстречу производным пострино.

После выхода из поверхности ядер атомов дисплея эфана Ариадны полупроводника получает самостоятельность и направляется к полюсам ядер атомов, в которых расположены эпострисики. В связи с тем, что все информационные пострино у поверхности дисплея трансформируются в фотоны, то полюсов ядер атомов, в которых расположены эпострисики, они достигнуть не могут. Если эфану Ариадны соединить с первым рядом квантонов эпострисиков, это равноценно тому, что мы использовали команду «сохранить».

Электроны тока выходят из поверхности дисплея и устремляются по эфанам Ариадны к сечению полупроводника дисплея, площадь сечения которого меньше площади дисплея в миллион раз. Группа электронов тока, выходящая из дисплея, должна вся одновременно поступить к сечению источника ЭДС. Одновременно! Следовательно, скорость перемещения электронов тока у поверхности дисплея может быть больше скорости света в миллион раз.

Экспериментатор не может наблюдать такие скорости, однако, факт, что всегда на поверхности дисплея изображение получается ровное, следовательно, все электроны группы из поверхности дисплея попадают в ядра атомов источника ЭДС.

Выходят электроны с поверхности дисплея вертикально, и только после выхода из полюсов ядер атомов изменяют направление на  $90^0$  и устремляются к сечению источника ЭДС.

Свечение фотонов, бывших накануне информационными пострино, наблюдаем в эксперименте. Перемещение электронов тока от поверхностного слоя полупроводника до входа тока в прибор происходит мгновенно. Свечение всех экранов полупроводниковых приборов осуществляется только таким образом.

*Символ на экране дисплея* – собранные в одну точку все эфаны Ариадны полупроводника, которые идут от чипа компьютера. Нажатие на символ вынуждает все эфаны Ариадны полупроводника с большей плотностью принимать плотность, разную плотности серий в курсоре. На дисплее в результате синтеза поверхностным слоем дисплея информационных пострино синтезируется изображение, которые превращается в фотоны. Убрать изображение из поверхности дисплея можно, если собрать все эфаны Ариадны полупроводника в одну точку. Мгновенно все эфаны Ариадны полупроводника возвращаются к первичному символу. Вновь получить изображение можно, если нажать на символ курсором.

#### 4. Курсор

При осмотре печатной платы "мышь" установлено, что по четырехпроводному кабелю напряжение питания 5 В поступает к выводам. Поскольку на плате отсутствуют позиционные обозначения элементов, здесь и далее нумерация деталей условна. В состав "мышь" входят три излучающих диода, фотодатчики, три токоограничительных резистора, три микропереключателя и четырех-контактный разъем.

Курсор представляет собой указатель, энергия фотонов, генерируемая чипом информационных серий которого несколько отличается от энергии, излучаемой фотонами поверхности дисплея. Курсор синтезируется отдельным чипом в виде символа. Средняя энергия фотонов укладывается в длины волн до 500 нм. Фотоны курсора и дисплея не принимают участие в процессах, протекающих на дисплее. Поле, создаваемое квантонами серий эфаны Ариадны полупроводника, устанавливает силовое взаимодействие с сериями эфаны Ариадны полупроводника курсора. Удивительно, но серии эфаны Ариадны полупроводника и курсора могут программироваться.

В центре дисплея по программе курсора набирается текст, от ядер атомов которых через пространство дисплея идет информация к элементу сохранения информации (чип). От чипа на ядра атомов центра дисплея поступает информация в виде потока эфан Ариадны, по которым перемещаются электроны на главных пострино и создают непрерывно изображение курсора. Сам курсор не в состоянии перемещаться по поверхности дисплея, так как он запитан от постоянного источника синтеза электрических пострино. В зависимости от величины сопротивления поверхности дисплея, курсор может перемещаться под действием проводящей системы (пальцы человека). После изображения курсора электроны тока уходят в окружающую среду поверхности слоя дисплея на массу. Все остальные электроны тока, выходящие с поверхности дисплея, направляются к одному проводнику - катоду. Перемещение на дисплее происходит в результате того, что из его поверхности выходят электроны тока и сопротивление пальца между поверхностью пальца и дисплеем меньше, чем сопротивление заземленной поверхности дисплея. Поэтому, под действием перемещения пальца будет перемещаться курсор.

Для перемещения курсора на дисплее, необходимо заставить курсор перемещаться под действием фотонов, излучаемых фотодиодом «мышки». В «мышке» имеется подведенный локальный источник света - светодиод или лазерное излучение (монохроматическое), поток фотонов которого направляется на коврик, отражается и попадает на поверхность фотодиода. Если «мышку» привести в движение в каком-то одном направлении, от поверхности «мышки» отправляются потоки фотонов к поверхности фотодиода со смещением. Происходит перемещение курсора нужному символу. При нажатии на курсор контакт между эфанами Ариадны полупроводника символа и «мышки» приводит к выполнению команд на дисплее.

Удивительно то, что согласно стандартной модели физики работа компьютеров и смартфонов вне этих законов. Все люди пользуются этими приборами, но не задумываются о том, что они не должны работать в принципе. Все законы, признанные в стандартной модели физики, не являются законами как таковыми, а представляют собой жалкое искажение реальности.

## 5. Выделение любого объекта

Команда «Выделить» происходит давлением на курсор, в результате чего происходит изменение эфаны Ариадны полупроводника на поверхности дисплея. Эта информация по эфане Ариадны полупроводника поступает к эпострисикам. В соответствии с изменившейся величиной давления, часть магнитных векторов квантонов электрических серий эпострисика меняется на  $180^0$ . Эта часть энергии принимает участие в синтезе новой эфаны Ариадны полупроводника и в «зеркальном копировании» информационных пострино, однако, их действие не проявляется. Измененные эфаны Ариадны полупроводника и информационные пострино поступают на свободный чип (*чип* - интегральная схема, то есть программируемый модуль, имеющий собственную память и логику), где сохраняют новые величины эпострисиков. Вся измененная энергия поступает на поверхность дисплея и возникает свечение экрана. Эпострисик синтезирует эфану Ариадны полупроводника, затем синтезируются информационные пострино, которые перемещаются к чипу прибора и к поверхности дисплея. В результате изменения энергии информационных пострино цвет изображения текста меняется и он может быть подвергнут *выделению, удалению, копированию*.

Выделенная на экране дисплея часть текста теперь может быть удалена путем воздействия на эпострисики чипа информационных пострино, или направлена на новый чип, минуя экран дисплея. Во втором случае происходит *копирование* текста. Скопированный текст сохраняется на чипе так долго, сколько необходимо для работы. Эта часть может быть вставлена в текст. Процесс происходит не на поверхности дисплея, а в чипах компьютера.

Как только эфана Ариадна полупроводника проходит *диэлектрик*, подобные процессы происходят в обычной электрической системе, если между пластинами конденсатора помещается диэлектрик с диэлектрической проницаемостью  $\epsilon$ . Ниже приведено описание процесса при действии на эфану Ариадны диэлектриков.

Только *диэлектрики* являются проницаемыми для отрицательных электрических пострино, которые проходят от катода к аноду, уменьшая величину энергии отрицательных электрических пострино. Остальные вещества являются непроницаемыми для них.

В момент ионизации ядер атомов синтезируется эфана Ариадны, которая пронизывает все проводники, полупроводники и диэлектрики и достигает второго конца полюса иона. Эфана Ариадны определяет свойства всех веществ, которые она пересекла. При помещении диэлектрика между пластинами конденсатора, эфана Ариадны проходит через полюса его ядер атомов и устанавливает время, которое протекает от момента завершения пересечения полюса наружными атринами пульсэда и наружными атринами спана. Они транспортируются эфаной Ариадны в момент времени завершения пересечения последним рядом квантонов серий эпостриса. Между первым рядом серий эпостриса и последним рядом квантонов эпостриса, эфана Ариадны отмечает точку времени пересечения полюса ядра атома наружными атринами спанов. Все магнитные вектора квантонов, расположенные между первым рядом серий эпостриса и точкой, отмеченной в момент пересечения полюса ядра атома наружными атринами спанов, изменяют на  $180^0$  направления действия собственных векторов (*свернутый эпострис*). Оставшиеся серии эпостриса у полюсов ядер атомов не изменяют направления магнитных векторов атрисов квантонов.

Теперь серии свернутого эпостриса могут производить зеркальное копирование только участков серий, которые не изменили свое направление на противоположное. Свернутый эпострис начинает синтезировать серии главных и производных пострино, по энергии равных отрезкам несвернутых векторов квантонов эпостриса. Уменьшенная энергия серий пострино свободно проходит через диэлектрик. Эфана у полюсов ядер атомов открывает их пересечение только после прохождения времени, равного прохождению последнего ряда квантонов наружных атринов спанов.

Диэлектрическая проницаемость диэлектрика будет рассчитываться как отношение энергии полного пострино к энергии свернутого участка. Как только из межэлектродного промежутка

извлекается диэлектрическая пластина, эфана Ариадны мгновенно разворачивает магнитные вектора квантонов эпостриса на  $180^{\circ}$ , и эпострис будет вновь синтезировать полноценные пострино. Если между межэлектродным промежутком поставить пластину с другой диэлектрической проницаемостью, то эфана Ариадны сразу реагирует, разворачивая на  $180^{\circ}$  магнитные квантоны электрических серий эпостриса в соответствии с размером участка серий наружных атринов спанов после пересечения всех серий наружных атринов пульседа.

## ***6. Удаление любого объекта***

Все энергоинформационные обмены осуществляются только через полюса ядер атомов в промежутках времени после завершения циклических колебаний наружных атринов пульсэдов и до завершения внутренних атринов пульсэдов.

Электрон может покинуть ядро атома только в том случае, если завершены все энергоинформационные обмены между полюсом ядра атома, электрическими пострино, и после взаимодействия производных вистр биртрона электрона с информационными пострино (синтез фотона).

При команде «удалить» к полюсам ядер атомов полупроводника направляются информационные пострино, энергия которых соответствует энергии фотонов, излучаемых поверхностью листа. Естественно, что в ядрах атомов полупроводника уже имеется записанная информация в виде эпострисиков (флеш-накопитель). Информационные пострино подходят к полюсам ядер атомов и устанавливают мгновенную силовую связь в полюсе с эпострисиками. Информационные пострино уменьшают свою длину волны в два раза, и это приводит к взаимной аннигиляции энергии эпострисиков и информационных пострино. Весь этот процесс происходит за время порядка  $10^{-68}$  сек. Естественно, никакими экспериментами определить эти явления невозможно.

При удалении всего текста необходимо создать аналогичную копию зеркального отображения и пропустить эти тексты параллельно через чипы.

## ***7. Копирование любого объекта??***

После выполнения функции «выделить» часть текста поступает в соседний чип, в котором синтезируются эпострисики. Из этого чипа текст может быть направлен на любую другую функцию.

## ***8. Сохранение любого объекта***

При команде «сохранить» происходит перенос конца эфаны Ариадны полупроводника с первым рядом квантонов собственного эпострисика. Эта команда определяется экспериментально и выделяется на панели компьютера.

## ***9. Печать***

Для печатания текста на поверхности дисплея создается белая поверхность, которая излучает длины волн в соответствии с белым цветом поверхности дисплея. Эта поверхность создается в результате равномерного излучения поверхностным слоем ядер атомов дисплея фотонов, которые возникают в результате трансформации положительных электрических пострино в фотоны.

Поле листа подвергнуто расчету. Согласно разработанной программе, движение курсора может происходить только вдоль строки. Курсор создается программой чипа, в котором уменьшено количество фотонов на единицу площади поверхности. Поэтому курсор представляет собой совершенно иное тело. Располагается курсор перед следующим символом.

При составлении алфавита для печати производится фотография будущих букв алфавита с длинами волн отражаемых фотонов в соответствии с длинами волн белого листа. Печать производится в том случае, если изображение буквы, которая представлена эпострисиками, идущими от чипа в виде белого листа, компенсируют эпострисики, создающие белый лист.

В месте значка на экране дисплея при возникновении силового давления на соответствующий символ направляется поток информационных пострино поверхности в данную



точку чипа. Информационные пострино вступают в мгновенную силовую связь с эпострисиками ядер атомов поверхности. Происходит их взаимная аннигиляция, а на дисплее возникает символ черного цвета. Так происходит печать на поверхности дисплея. Само явление происходит в чипе, а на поверхности возникает определенный символ.

Линия курсора смещается на размер символа самопроизвольно, так как эта позиция занята символом. Символ указывает будущее место последующей печати.

### ***10. Заливка***

Заливка цвета происходит на чипе на местах отсутствия эпострисиков, которые удалены в результате печати текста или в результате создания черных точек поверхности при использовании программы Тефлекс.

Удаление цвета происходит при повторном нажатии команды «цвет» данной длины волны. В этом случае цветовой пострино достигают эпострисиков и аннигилируют с ними, так как у них длины волн находятся в соответствии.

### ***Выводы***

1. Открыта природа процессов, протекающих в чипах компьютера в соответствии с Атрисной физикой.

2. Все процессы, протекающие в чипах компьютера, были открыты ранее и использованы в работе.

3. Конструкторы смартфонов и компьютеров должны были знать заранее Атрисную физику или получить результаты в процессе бесконечных экспериментов.

### ***Литература***

1. Поляков С.П. «Атрисное строение материи», М.: Международный гуманитарный фонд «Знание».-1999, Т.1., 183 с. илл.

2. Поляков С.П. «Разумная жизнь Вселенной», М.: Информ – Знание, 2000 г. – 249 с., илл.

3. Поляков С.П. «Путь осознания вечности», М.: Информ – Знание, 2002 г. – 2008 с., илл.

4. Поляков С.П. Атрисна фізика електрона: Частина 1.- Черкаси: ЧДТУ. 2006.- 55 с., іл.

5. Поляков С.П. Атрисная структура кристаллов, М.: Информ-Знание, 2007.-191с., илл.

6. Сайт: [atrisov.narod.ru](http://atrisov.narod.ru).

Доктор технических наук, профессор *Поляков Святослав Петрович*

18002, г. Черкассы, бульв. Шевченко, 245, кв.5, дом. тел. (8-1038-0472) 54-22-87

E-mail: [atrisov@yandex.ru](mailto:atrisov@yandex.ru).